



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120405000
2012 年 4 月 11 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL C10 プロセス 一部製品 前処理サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	HVAL C10プロセス 一部製品 前処理サイト追加 現行 : TI-FFAB(Freising, ドイツ) 変更後 : TI-FFAB(Freising, ドイツ), TI-CFAB(中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	7 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容:弊社 HVAL(ハイボリュームアナログロジック) C10プロセス 一部製品の前処理サイトについて、現行 TI-FFAB(Freising, ドイツ)サイトに製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-CFAB(中国)サイトでの製造を追加します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

C10プロセス前処理サイト

ウェーハ径

現行

TI-FFAB(Freising, ドイツ)

200 mm

変更後

TI-FFAB(Freising, ドイツ)

TI-CFAB(中国)

200 mm

理由 : 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
74AVC20T245DGGE4	SN74AVC2T45YZTR	TS3L301DGG	TS5A3159ADCKTE4	TS5A9411DCKTG4
74AVC20T245DGGG4	SN74LVCH16245ADGG	TS3L301DGGE4	TS5A3159ADCKTG4	TXB0106PW-P
74AVC20T245DGGRE4	SN74LVCH16245ADGGR	TS3L301DGGG4	TS5A3160DBVR	TXB0106PWR
74AVC20T245DGGRG4	SN74LVCH16245ADGVR	TS3L301DGGR	TS5A3160DBVRE4	TXB0106PWRG4
74AVC20T245DGVRE4	SN74LVCH16245ADL	TS3L301DGGRE4	TS5A3160DBVRG4	TXB0106RGYR
74AVC20T245DGVRG4	SN74LVCH16245ADLG4	TS3L301DGGRG4	TS5A3160DBVT	TXB0106RGYRG4
74LVCH16245ADGGE4	SN74LVCH16245ADLR	TS3L301DGVR	TS5A3160DBVTE4	TXB0108DQSR
74LVCH16245ADGGG4	SN74LVCH16245AG-P	TS3L301DGVRE4	TS5A3160DBVTG4	TXB0108PWR
74LVCH16245ADGGRG4	SN74LVCH16245AGQLR	TS3L301DGVRG4	TS5A3160DCKJ	TXB0108PWRG4
74LVCH16245ADGVRE4	SN74LVCH16245AGRDR	TS3USB31RSER	TS5A3160DCKR	TXB0108RGYR
74LVCH16245ADGVRG4	SN74LVCH16245AZQLR	TS3USB31RSERG4	TS5A3160DCKRE4	TXB0108RGYRG4
74LVCH16245ADLRG4	SN74LVCH16245AZRDR	TS5A23166YZPR	TS5A3160DCKRG4	TXS0104ED
AVC20T245DGG-R	SN74LVCH32245AGKER	TS5A23166YZTR	TS5A3160DCKT	TXS0104EDG4
AVC20T245DGV-R	SN74LVCH32245AZKER	TS5A26542YZTR	TS5A3160DCKTE4	TXS0104EDR
AVC20T245ZQLR-D	TPD2S017DBVR	TS5A3159ADBVR	TS5A3160DCKTG4	TXS0104EDRG4
HPA00655RSER	TPD4E001DCKR	TS5A3159ADBVRG4	TS5A3167DBVR	TXS0104EPWR
HPA00960RUAR	TS3DV416DGG	TS5A3159ADBVRG4	TS5A3167DBVRE4	TXS0104EPWRG4
SN74AUP1G08YZPR	TS3DV416DGGRE4	TS5A3159ADBBVT	TS5A3167DBVRG4	TXS0104ERGYR
SN74AUP1G97YZPR	TS3DV416DGGRG4	TS5A3159ADBBVTE4	TS5A3167DCKR	TXS0104ERGYRG4
SN74AUP1T97YZPR	TS3DV416DGV	TS5A3159ADBBVTG4	TS5A3167DCKRE4	TXS0108EPWR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

SN74AVC20T245DGG	TS3DV416DGVGR4	TS5A3159ADCKR	TS5A3167DCKRG4	TXS0108EPWRG4
SN74AVC20T245DGGR	TS3DV520ERHUR	TS5A3159ADCKRE4	TS5A9411DCKR	TXS0108ERGYR
SN74AVC20T245DGVGR	TS3DV520ERHURG4	TS5A3159ADCKRG4	TS5A9411DCKRG4	TXS0108EZXYR
SN74AVC20T245ZQLR	TS3DV520ERUAR	TS5A3159ADCKT	TS5A9411DCKT	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記のようになります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TI-FFAB	TI-CFAB
CSO (20L): 前処理サイト記号	TID	CU3
CCO (21L): 生産国記号	DEU	CHN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年11月1日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74AVC16T245DGGR	-	-	
Wafer Fab Site:	CFAB	Wafer Fab Process:	33C10	
Wafer Diameter(mm):	200	Metallization:	Ti/TiN/AlCu.5%/TiN	
Passivation:	10KACN	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77/0	77/0	77/0
Electrical Characterization	-	77/0	77/0	77/0
High Temp. Storage Bake	170C, 168, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Wafer level Reliability	Approved by TDQRE	Approved	Approved	Approved
Wafer Fab MQ	Per site spec	Approved	Approved	Approved
Assembly / Test MQ	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Latch-up	per JESD78	6/0	6/0	6/0
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	-	-
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 12 月	終了	2012 年 4 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TS3L500AERHUR	-	-	
Wafer Fab Site:	CFAB	Wafer Fab Process:	33C10	
Wafer Diameter(mm):	200	Metallization:	Ti/TiN/NCu0.5%/TiN	
Passivation:	10KACN	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
High Temp. Storage Bake	170C, 168, 420 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD HBM	2000V	3	3	3
ESD CDM	500V	3	3	3
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Wafer level Reliability	Approved by TDQRE	per spec	per spec	per spec
Latch-up	per JEDEC78	6	6	6
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Wafer Fab MQ	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 5 月	終了	2012 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPD2S017DBVR	-	-	
Wafer Fab Site:	CFAB	Wafer Fab Process:	33C10	
Wafer Diameter(mm):	200	Metallization:	Ti/TiN/NCu0.5%/TiN	
Passivation:	10KACN	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77	-	-
Electrical Characterization	-	per spec	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD HBM	2000V	3	-	-
ESD CDM	500V	3	-	-
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Latch-up	per JEDEC78	6	-	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Wafer Fab MQ	per mfg. Site specification	per spec	-	-
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/260C				